(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許番号

第2539641号

(45)発行日 平成8年(1996)10月2日

(24)登録日 平成8年(1996)7月8日

技術表示箇所

最終頁に続く

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

G 0 3 G 5/06

312

G03G 5/06

312

発明の数1(全12頁)

(21)出顯番号	特膜昭62-277160	(73)特許権者 99	9999999
(22)出顧日	昭和62年(1987)10月30日	i i	田工業株式会社 阪府大阪市中央区玉造1丁目2番28号
(65)公開番号	特開平1-118141		藤 成昭 阪府大阪市東区玉造1丁目2番28号
(43)公開日	平成1年(1989)5月10日	1 1	田工業株式会社内
		大	本 栄一 阪府大阪市東区玉造1丁目2番28号 田工業株式会社内
		大	沢 字 阪府大阪市東区玉造1丁目2番28号 田工業株式会社内
		(74)代理人 弁3	理士 龟井 弘勝 (外1名)
		審査官 深	車 弘

(54) 【発明の名称】 電子写真用感光体

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】導電性基材上に感光層が形成された感光体

 $(R^{1})_{m}$ $(R^{3})_{0}$ $(R^{3})_{0}$ $(R^{2})_{n}$ $(R^{4})_{p}$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 は、同一または異なって、 水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基またはハロゲン原子を示す。 Yは、水素原子、低級アルキル基、 低級アルコキシ基またはハロゲン原子を示す。 1は $1 \sim 1$ 3 の整数を示す。 $1 \sim 1$ 成业 屈 水て

において、上記感光層が下記一般式 (1) で表される化 合物を含有することを特徴とする電子写真用感光体。

(1)

示す。但し、 \mathbf{R}^1 、 \mathbf{R}^2 、 \mathbf{R}^3 および \mathbf{R}^4 は同時に水素原子ではないものとし、水素原子でない前記 \mathbf{R}^1 、 \mathbf{R}^2 、 \mathbf{R}^3 および \mathbf{R}^4 の \mathbf{m} 、 \mathbf{n} 、 \mathbf{o} および \mathbf{p} は、少なくとも $\mathbf{1}$ つが $\mathbf{2}$ であるものとする。)

【請求項2】 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 が、同一または異なっ

て、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のアルコキシ基またはハロゲン原子である上記特許請求の範囲第 1項記載の電子写真用感光体。

【請求項3】 Yが、炭素数1~4のアルキル基、炭素数1~4のアルコキシ基またはハロゲン原子である上記特許請求の範囲第1項記載の電子写真用感光体。

【請求項4】感光層が、メタルフリーフタロシアニンまたはチタニルフタロシアニンを含有する上記特許請求の 範囲第1項記載の電子写真用感光体。

【発明の詳細な説明】

<産業上の利用分野>

本発明は、複写機などの画像形成装置において好適に使用される電子写真用感光体に関する。

<従来の技術と発明が解決しようとする問題点>

近年、電子写真用感光体として、機能設計の自由度が 大きな感光体、中でも光照射により電荷を発生する電荷 発生材料と、発生した電荷を輸送する電荷輸送材料とを 含有する感光層を備えた電子用写真感光体が提案されて いる。より詳細には、電荷発生材料と電荷輸送材料とを 含有する単層型感光層を備えた感光体、例えば、電荷発 生材料としての多環式芳香族炭化水素と、電荷輸送材料 としてのポリビニルカルバゾールとを含有する単層型感 光層を有する感光体(特開昭56-143438号公報)や、上 記電荷発生材料を含有する電荷発生層と、電荷輸送材料 を含有する電荷輸送層とが積層された積層型感光層を備 えた感光体、例えば、電荷発生材料としてスクエアリン 酸誘導体を含有する電荷発生層と、4,4′-ビス[N-フェニル-N-(3-メチルフェニル) アミノ] ジフェ ニルなどのジアミン誘導体を含有する電荷輸送層とが積 層された感光体(特開昭57-144558号公報、特開昭61-62038号公報参照)、上記電荷発生材料に代えて、シア ニン系化合物、アゾ系化合物、N,N′-ビス (2,4,6-ト リメチルフェニル) ペリレン-3,4,9,10-テトラカルボ キシジイミド、N,N′-ジフェニルペリレン-3,4,9,10 ーテトラカルポキシジイミドや、N,N′ –ジメチルペリ レンー3,4,9,10-テトラカルボキシジイミドなどのペリ レン系化合物を用いた電子写真用感光体 (特開昭57-14 4556号公報、特開昭57-144557号公報、特開昭60-2071 48号公報、特開昭61-275848号公報、特開昭61-132955 (R')m

 $(R^2)_0 \qquad (R^4)_p$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 は、同一または異なって、水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基またはハロゲン原子を示す。 Y は、水素原子、低級アルキル基、

号公報参照)などが提案されている。また、上記電荷翰送材料として、4-(N,N-3)エチルアミノ)ベンズアルデヒド N,N-3フェニルヒドラゾン、N-1エチルー3-カルパゾリルアルデヒド N,N-3フェニルヒドラゾンなどのヒドラゾン系化合物や1-1フェニルー3-(4-3エチルアミノスチリル) 1-10-(4-31-1) ピラゾリンなどのピラゾリン系化合物を使用することも提案されている。

上記感光体、特に積層型感光層を有する感光体は、電 10 荷発生材料により発生させる電荷発生機能と、発生した 電荷を電荷輸送材料により輸送する電荷輸送機能とが分 離しているので、感度が大きく、残留電位の小さな感光 体が得られるという利点がある。

しかしながら、上記感光体の感光層に使用されている 電荷輸送材料としてのポリビニルカルバゾール、前記ヒ ドラゾン系化合物およびピラゾリン系化合物は、ドリフ ト移動度に関して大きな電界強度依存性を示すだけでな く、ドリフト移動度が小さいため、残留電位が大きいだ けでなく、感度が小さく、未だ十分な電子写真特性を示 さない。

一方、前記ジアミン誘導体は、上記電荷輸送材料よりもドリフト移動度が大きいものの、前記ペリレン系化合物などの電荷発生材料と組合せて、単層型または積層型感光層を形成しても、残留電位が未だ大きく感度も十分でないという問題がある。

また、上記ヒドラゾン系化合物は、光照射により光異性化、光二量化反応などが生じるため、光安定性が十分でなく、繰返し使用により感度が低下すると共に、残留電位が増加するという問題がある。

30 <発明の目的>

本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、光 安定性に優れるとともに、感度が高く、しかも残留電位 が小さな電位写真用感光体を提供することを目的とす る。

<問題点を解決するための手段および作用>

上記目的を達成するため、本発明の電子写真用感光体は、導電性基材上に感光層が形成された感光体において、上記感光層が下記一般式(1)で表される化合物を含有することを特徴とする。(R¹)。

低級アルコキシ基またはハロゲン原子を示す。1は $1\sim$ 3の整数を示す。m、n、oおよびpは $0\sim2$ の整数を50示す。但し、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 は同時に水素原子では

(1)

ないものとし、水素原子でない前記R¹、R²、R³およびR⁴ のm、n、oおよびpは、少なくとも1つが2であるも のとする。)

以下に、本発明を詳細に説明する。

٠<u>.</u> *

本発明の電子写真用感光体は、導電性基材上に上記一 般式(1)で表される化合物を含有する感光層が形成さ れている。

上記導電性基材は、シート状やドラム状のいずれであ ってもよく、基材自体が導電性を有するか、基材の表面 が導電性を有し、使用に際し十分な機械的強度を有する ものが好ましい。上記導電性基材としては、導電性を有 する種々の材料が使用でき、例えば、アルミニウム、 銅、錫、白金、金、銀、パナジウム、モリブデン、クロ ム、カドミウム、チタン、ニッケル、パラジウム、イン ジウム、ステンレス鋼、真鍮などの金属単体や、上記金 属が蒸着または積層されたプラスチック材料、ヨウ化ア ルミニウム、酸化錫、酸化インジウム等で被覆されたガ ラス等が例示される。上記導電性基材のうち、アルミニ ウム、特に、アルミニウムの結晶粒が表面に存在せず、 複写画像等において黒点やピンホール等が発生するのを 防止すると共に、上記ペリレン系化合物、ジアミン誘導 体等を含有する感光層と基材との密着性をよくするた め、アルマイト処理されたアルミニウム、中でもアルマ イト処理層の膜厚が5~12μmであり、表面粗さが1.5S 以下のアルマイト処理されたアルミニウムが好ましい。

上記感光層に含有される一般式 (1) で表される化合 物において、低級アルキル基としては、メチル、エチ ル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、te rt-ブチル、ペンチル、ヘキシル基などの炭素数1~6 のアルキル基が例示される。上記低級アルキル基のう ち、炭素数1~4のアルキル基が好ましい。

また、低級アルコキシ基としては、メトキシ、エトキ シ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブト キシ、tert – ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシルオキ シ基などの炭素数1~6のアルコキシ基が例示される。 上記低級アルコキシ基のうち、炭素数1~4のアルコキ シ基が好ましい。

また、ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素お よびヨウ素原子が挙げられる。

なお、上記置換基 \mathbb{R}^1 、 \mathbb{R}^2 、 \mathbb{R}^3 および \mathbb{R}^4 は、ベンゼン環 のo-位、m-位、p-位のいずれに置換していてもよ く、前記置換基Yは、ベンゼン環の適宜の位置に置換し ていてもよい。

また、上記一般式(1)で表されるジアミン誘導体に おいて、1=1のp-フェニレンジアミン誘導体のう ち、好ましい化合物としては、例えば、1-[N-(3,(N,N-ジフェニルアミノ) ベンゼン、1 - [N,N-ジ・ (3,5-3) (3,5-3) (3,5-3) (3,5-3) (3,5-3)

チルフェニル) -N-フェニルアミノ] ベンゼン、<math>1,4- \forall z = 1z = 1zルアミノ] ベンゼン、1,4-ピス [N- (3,5-ジメチル フェニル) - N - フェニルアミノ] ベンゼン、1,4-ビ ス [N,N-ピス (3,5-ジメチルフェニル) アミノ] ベン ゼン、1-[N,N-ジ(2,4-ジメチルフェニル)アミ ノ] - 4 - [N,N-ジ (2,6-ジメチルフェニル) アミ ノ] ベンゼン、1-[N,N-ジ (2,4-ジメチルフェニ ル) アミノ] -4-[N,N-ジ (3,5-ジメチルフェニ10 ル) アミノ] ベンゼン、1 - [N,N-ジ (2,6-ジメチル フェニル) アミノ] - 4 - [N,N-ジ (3,5-ジメチルフ エニル) アミノ] ベンゼン、1-[N,N-ジ (3,5-ジメ チルフェニル) アミノ] - 4 - (N,N-ジフェニルアミ ノ) -2-メチルベンゼン、1,4-ビス [N-(3,5-ジ メチルフェニル) -N-フェニルアミノ] -2-メチルペンゼン、1,4-ピス [N,N-ピス (3,5-ジメチルフェ $-\mu$) アミノ] -2-メチルベンゼン、1,4-ヒス [N]-(3,5-ジメチルフェニル) - N - フェニルアミノ]-2-メトキシベンゼン、1,4-ビス [N,N-ビス (3,5 20 -ジメチルフェニル) アミノ] -2-メトキシベンゼ ン、1,4-ビス [N-(3,5-ジメチルフェニル)-N-フェニルアミノ] -2-クロロベンゼン、1,4-ビス クロロベンゼン、1,4-ピス[N-(3,5-ジメチルフェ ニル) -N-フェニルアミノ]-2-プロモベンゼン、1,4- \forall ス [N-(2,4-ジェチルフェニル) -N-フェ ニルアミノ] ベンゼン、1,4-ピス [N-(3,5-ジエチ ルフェニル) -N-フェニルアミノ] ベンゼン、<math>1.4-ビス [N,N-ビス (3,5-ジエチルフェニル) アミノ] ベ 30 ンゼン、1,4-ビス [N-(3,5-ジプロピルフェニル) -N-フェニルアミノ] ベンゼン、1,4-ビス [N,N-ビ ス(3,5-ジプロピルフェニル)アミノ]ベンゼン、1 - [N,N-ジ (3,5-ジイソプロピルフェニル) アミノ] -4-(N,N-ジフェニルアミノ) ベンゼン、<math>1,4-ビス[N-(3,5-ジイソプロピルフェニル)-N-フェニルアミノ] ベンゼン、1,4-ピス [N,N-ピス (3,5-ジ・ イソプロピルフェニル)アミノ]ベンゼン、1,4-ビス [N-(3,5-3)] - N-0 = N-**ノ] ベンゼン、1,4-ビス [N,N-ビス (3,5-ジブチル** 40 フェニル) アミノ] ベンゼン、1,4-ビス [N-(3,5-ジイソプチルフェニル) - N - フェニルアミノ] ベンゼ ン、1,4-ビス [N,N-ビス (3,5-ジイソブチルフェニ ル) アミノ] ベンゼン、1 - [N,N-ジ (3,5-ジーtert -ブチルフェニル) アミノ] -4- (N,N-ジフェニル アミノ) ベンゼン、1,4-ピス [N-(3,5-ジーtert-ブチルフェニル) -N-フェニルアミノ] ベンゼン、1、4-ピス [N,N-ピス (3,5-ジーtert-ブチルフェニ ル) アミノ] ベンゼン、1 - [N - (3,5-ジメチルフ x=1 -N-7 -ェニルアミノ) ベンゼン、1,4-ピス $\begin{bmatrix} \mathbf{N}-& (2,4-arphi)\mathbf{y} & 50 \end{bmatrix}$ ジエチルフェニル $\mathbf{N}-\mathbf{N}-\mathbf{N}-\mathbf{N}$ ェニルアミノ $\mathbf{N}-\mathbf{N}-\mathbf{N}-\mathbf{N}$

1 - [N,N-ジ (3,5-ジメチルフェニル) アミノ] - 4 - [N,N-ジ(3,5-ジエチルフェニル) アミノ] ベンゼ ン、1 - [N - (3,5 - ジメチルフェニル) - N - フェニル) -N-フェニルアミノ] ベンゼン、<math>1-[N,N-ジ (3,5-ジメチルフェニル) アミノ] - 4 - [N,N-ジ (3,5-ジイソプロピルフェニル) アミノ] ベンゼン、 1 - [N - (3,5 - ジメトキシフェニル) - N - フェニルアミノ] -4- (N,N-ジフェニルアミノ) ベンゼ ン、1 - [N, N-ジ (3,5-ジメトキシフェニル) アミJ] -4-(N,N-ジフェニルアミノ) ベンゼン、<math>1,4-ピス [N-(2,4-ジメトキシフェニル)-N-フェニ ルアミノ] ベンゼン、1,4-ピス [N-(3,5-ジメトキ シフェニル) -N-フェニルアミノ] ベンゼン、<math>1,4-ピス [N-(2,6-ジメトキシフェニル)-N-フェニ ルアミノ] ベンゼン、1,4-ビス [N,N-ビス (3,5-ジ メトキシフェニル) アミノ] ベンゼン、1- 「N.N-ジ (2,4-ジメトキシフェニル) アミノ] - 4 - [N,N-ジ(2,6-ジメトキシフェニル) アミノ] ベンゼン、1-[N,N-ジ (2,4-ジメトキシフェニル) アミノ] -4-[N,N-ジ(3,5-ジメトキシフェニル) アミノ] ベンゼ ン、1-[N,N-ジ(2,6-ジメトキシフェニル)アミ ノ] - 4 - [N,N-ジ (3,5-ジメトキシフェニル) アミ ニル) - N - フェニルアミノ] ベンゼン、1,4- ビス [N,N-ジ (3,5-ジエトキシフェニル) アミノ] ベンゼ **ン、1,4-ピス[N- (3,5-ジプロポキシフェニル) -**(3,5-ジプロポキシフェニル) アミノ] ベンゼン、1 - [N,N-ジ (3,5-ジイソプロポキシフェニル) アミ ノ] - 4 - (N,N-ジフェニルアミノ) ベンゼン、1.4- $\forall X [N-(3,5-y)] = (3,5-y) = (3,5-y)$ フェニルアミノ] ベンゼン、1,4-ビス [N,N-ビス (3, 5-ジイソプロポキシフェニル) アミノ] ベンゼン、1,4 -ビス [N-(3,5-ジプトキシフェニル)-N-フェニルアミノ] ベンゼン、1,4-ピス [N,N-ピス (3,5-ジブトキシフェニル)アミノ]ベンゼン、1,4-ビス [N-(3,5-3)] - N-7ルアミノ] ベンゼン、1,4-ビス [N,N-ビス (3,5-ジ イソプトキシフェニル) アミノ] ベンゼン、1-[N- $(3,5-\mathcal{S}-\text{tert}-\mathcal{T})$ $-N-\mathcal{T}$ アミノ] -4-(N,N-ジフェニルアミノ) ベンゼン、1- [N,N-ジ (3,5-ジーtert-ブトキシフェニル) ア -ピス [N- (3,5-ジ-tert-プトキシフェニル) -(3,5-ジ-tert-ブトキシフェニル) アミノ] ベンゼ ン、1 - [N - (3,5 - ジメトキシフェニル) - N - フx=nr = [N - (3,5-yx) + 2y = 1] ν) -N-フェニルアミノ] ベンゼン、<math>1-[N,N-ジ

(3,5-ジメトキシフェニル) アミノ] - 4 - [N,N-ジ (3,5-ジエトキシフェニル) アミノ] ベンゼン、1-[N-(3,5-3)] + N-2[0.5] [0.5] [0.5] [0.5] [0.5] [0.5] [0.5] [0.5] [0.5]ル) -N-フェニルアミノ] ベンゼン、<math>1-[N,N-ジ(3,5-3) (3,5-3) (3,5-3) (3,5-3) (3,5-3) (3,5-3)(3,5-ジイソプロポキシフェニル) アミノ] ベンゼ ン、1-[N-(3,5-ジクロロフェニル)-N-フェ ニルアミノ] -4-(N,N-ジフェニルアミノ) ベンゼ10 ン、1 - [N,N-ジ (3,5-ジクロロフェニル) アミノ] -4-(N,N-ジフェニルアミノ)ベンゼン、1,4-ビス [N-(2,4-9)/00]ノ] ベンゼン、1,4-ビス [N- (2,6-ジクロロフェニ ル) -N-フェニルアミノ] ベンゼン、1,4-ピス [N]- (3,5-ジクロロフェニル) -N-フェニルアミノ]ベンゼン、1-[N,N-ジ(2,4-ジクロロフェニル)ア ミノ] - 4 - [N,N-ジ (2,6-ジクロロフェニル) アミ ノ] ベンゼン、1 - [N,N-ジ (2,4-ジクロロフェニ ル) アミノ] -4- [N,N-ジ (3,5-ジクロロフェニ ル) アミノ] ベンゼン、1 - [N,N-ジ (2,6-ジクロロ フェニル) アミノ] - 4 - [N,N-ジ (3,5-ジクロロフ エニル) アミノ] ベンゼン、1,4-ビス [N- (3,5-ジ クロロフェニル) -N-フェニルアミノ] -2-クロロベンゼン、1,4-ビス [N,N-ビス (3,5-ジクロロフェ ニル) アミノ] -2-クロロベンゼン、1,4-ピス [N]-(3,5-i) \mathcal{I} $\mathcal{I$ ベンゼン、1,4-ビス [N,N-ビス (3,5-ジブロモフェ ニル) アミノ] ベンゼンなどが例示される。

また、1=2のベンゼン誘導体のうち、好ましい化合 30 物としては、例えば、4-[N-(3,5-ジメチルフェニル) -N-フェニルアミノ]-4′-(N,N-ジフェニルアミノ) ジフェニル、4- [N,N-ジ (3,5-ジメチ ルフェニル) アミノ]-4'-(N,N-ジフェニルアミノ) ジフェニル、4,4′-ビス [N-(2,4-ジメチルフ ェニル) -N-フェニルアミノ] ジフェニル、<math>4,4'- $\forall X [N-(2,6-3)] = N-(2,1)$ アミノ] ジフェニル、4,4' -ピス [N-(3,5-ジメチルフェニル) - N - フェニルアミノ] ジフェニル、4 -[N,N-ジ (2,4-ジメチルフェニル) アミノ] - 4′-[N,N-ジ(2,6-ジメチルフェニル) アミノ] ジフェニ ル、4 - [N, N-ジ (2, 4-ジメチルフェニル) アミノ] $-4' - [N, N-\Im (3, 5-\Im J + N)]$ ジフェニル、4-[N,N-ジ(2,6-ジメチルフェニル) アミノ] -4' - [N,N-ジ (3,5-ジメチルフェニル) アミノ] ジフェニル、4 - [N - (3,5 - ジメチルフェニル) -N-フェニルアミノ]-4'-(N,N-ジフェニルアミノ) -2,2' -ジメチルジフェニル、4-[N,N]ージ (3,5-ジメチルフェニル) アミノ] -4' - (N,N)ージフェニルアミノ)-2,2′-ジメチルジフェニル、 50 4,4′-ビス [N-(3,5-ジメチルフェニル)-N-フ

ェニルアミノ] -2,2' - ジメチルジフェニル、<math>4,4' -ピス [N-(3,5-ジメチルフェニル)-N-フェニルアミノ] -3,3' - ジメチルジフェニル、<math>4,4' - ヒス[N,N-ジ(3,5-ジメチルフェニル) アミノ] -2,2' ージメチルジフェニル、4,4′-ビス[N-(3,5-ジメ チルフェニル) -N-フェニルアミノ] -2,2' -ジメトキシジフェニル、4,4′-ビス [N,N-ジ (3,5-ジメ チルフェニル) アミノ] -2,2′ -ジメトキシジフェニ ル、4,4' -ビス [N-(3,5-ジメチルフェニル) - N-フェニルアミノ] -2,2' -ジクロロジフェニル、4,4′-ピス [N,N-ジ (3,5-ジメチルフェニル) アミ **ノ] −2,2′ −ジクロロジフェニル、4,4′ −ピス [N−** (3,5-ジェチルフェニル) - N - フェニルアミノ] ジフェニル、4,4′-ビス [N,N-ジ (3,5-ジエチルフェ ニル) アミノ] ジフェニル、4,4′-ビス [N- (3,5-ジプロピルフェニル) - N - フェニルアミノ] ジフェニ ル、4,4′-ビス [N,N-ジ (3,5-ジプロピルフェニ ル) アミノ] ジフェニル、4 - [N, N-ジ (3,5-ジイソ)]プロピルフェニル) アミノ] - 4′- (N,N-ジフェニ ルアミノ) ジフェニル、4,4' - ピス [N-(3,5-ジイソプロピルフェニル) - N - フェニルアミノ] ジフェニ ル、4,4′-ビス [N,N-ジ (3,5-ジイソプロピルフェ ニル) アミノ] ジフェニル、4,4′-ビス [N- (3,5-ジブチルフェニル) - N - フェニルアミノ] ジフェニ ル、4,4′-ビス [N,N-ジ (3,5-ジブチルフェニル) アミノ] ジフェニル、4,4′-ピス [N-(3,5-ジイソ **_ブチルフェニル)-N-フェニルアミノ] ジフェニル、** 4,4′-ビス [N,N-ジ (3,5-ジイソブチルフェニル) アミノ] ジフェニル、4- [N,N-ジ (3,5-ジ-tert-ブチルフェニル) アミノ] - 4′- (N,N-ジフェニル アミノ) ジフェニル、4,4′ーピス [Nー (3,5ージーte rt-ブチルフェニル) -N-フェニルアミノ] ジフェニ ル、4,4′-ビス [N,N-ジ (3,5-ジーtert-ブチルフ ェニル) アミノ] ジフェニル、4 - [N - (3,5 - ジメトキシフェニル) -N-フェニルアミノ] -4'-(N,N-ジフェニルアミノ) ジフェニル、 <math>4-[N,N-ジ (3,5-ジメトキシフェニル) アミノ] - 4′- (N,N-ジフ エニルアミノ) ジフェニル、4,4′-ビス [N-(2,4-ジメトキシフェニル) - N - フェニルアミノ] ジフェニ ル、4,4' -ビス [N-(2,6-ジメトキシフェニル) -N-フェニルアミノ] ジフェニル、<math>4,4' -ピス [N-(3,5-3) + 2 + 2 + 2 + 3 + 4 ジフェニル、4,4′-ビス [N,N-ジ (3,5-ジメトキシ フェニル) アミノ] ジフェニル、4 - [N,N-ジ (2,4-ジメトキシフェニル) アミノ] - 4′- [N,N-ジ (2,6 ージメトキシフェニル)アミノ]ジフェニル、4-[N, N-ジ (2,4-ジメトキシフェニル) アミノ] -4′-[N,N-ジ(3,5-ジメトキシフェニル) アミノ] ジフェ ニル、4 - [N, N - ジ (2,6 - ジメトキシフェニル) アミノ] -4'-[N,N-ジ(3,5-ジメトキシフェニル) ア 50 -ジクロロフェニル) アミノ] ジフェニル、4-[N,N-2]

ミノ] ジフェニル、4,4′-ピス [N-(3,5-ジメトキ シフェニル) -N-フェニルアミノ] -2,2' -ジメチルジフェニル、4,4' - \forall ス [N - (3,5- ジメトキシフ ェニル) -N-フェニルアミノ] -3,3' -ジメチルジフェニル、4,4′-ピス [N,N-ジ (3,5-ジメトキシフ ェニル) アミノ] -2,2' -ジメチルジフェニル、4,4'**-ビス [N-(3,5-ジメトキシフェニル)-N-フェ** ニルアミノ] -2,2′ -ジメトキシジフェニル、4,4′ -ピス [N,N-ジ (3,5-ジメトキシフェニル) アミノ] -10 2,2′ -ジメトキシジフェニル、4,4′ -ビス [N- (3, 2′ -ジクロロジフェニル、4,4′ -ピス [N,N-ジ (3,5 ージメトキシフェニル) アミノ] -2,2′ -ジクロロジ フェニル、4,4' - \forall ス [N - (3,5- ジェトキシフェニ ル) -N-フェニルアミノ] ジフェニル、<math>4,4'-ビス[N,N-ジ(3,5-ジエトキシフェニル) アミノ] ジフェ **ニル、4,4′-ビス [N- (3,5-ジプロポキシフェニ** ル) -N-フェニルアミノ] ジフェニル、4,4′-ビス[N,N-ジ (3,5-ジプロポキシフェニル) アミノ] ジフ 20 ェニル、4 - [N, N-ジ (3,5-ジイソプロポキシフェニ ν) アミノ] -4' - (N,N-ジフェニルアミノ) ジフェニル、4,4' - ピス [N-(3,5-ジイソプロポキシフx=n) -N-フェニルアミノ] ジフェニル、<math>4,4'-ビス [N,N-ジ (3,5-ジイソプロポキシフェニル) アミ ノ] ジフェニル、4,4' - ビス [N-(3,5-ジプトキシフェニル) -N-フェニルアミノ] ジフェニル、<math>4,4'-ビス [N,N-ジ (3,5-ジブトキシフェニル) アミノ] ジフェニル、4,4' - \forall ス [N-(3,5-ジイソプトキシ フェニル) -N-フェニルアミノ] ジフェニル、<math>4,4'30 - ビス [N,N-ジ (3,5-ジイソプトキシフェニル) アミ ノ] ジフェニル、4- [N,N-ジ (3,5-ジーtert-ブト キシフェニル) アミノ] - 4′- (N,N-ジフェニルア ミノ) ジフェニル、4,4′-ビス [N-(3,5-ジーtert -ブトキシフェニル) -N-フェニルアミノ] ジフェニ ル、4,4′-ビス [N,N-ジ (3,5元ジーtert-プトキシ フェニル) アミノ] ジフェニル、4- [N,N-ジ (3,5-ジクロロフェニル) アミノ] -4′- (N,N-ジフェニ ルアミノ) ジフェニル、4,4′-ビス [N-(2,4-ジク production = pr40 4'-ビス [N-(2,6-ジクロロフェニル)-N-フェ ニルアミノ] ジフェニル、4,4′-ビス [N-(3,5-ジ クロロフェニル) -N-フェニルアミノ] ジフェニル、4,4′-ビス [N,N-ジ (3,5-ジクロロフェニル) アミ **ノ] ジフェニル、4-[N,N-ジ(2,4-ジクロロフェニ** ル) アミノ] - 4′ - [N,N-ジ (2,6-ジクロロフェニ ル) アミノ] ジフェニル、4 - [N,N-ジ (2,4-ジクロ ロフェニル) アミノ] - 4′ - [N,N-ジ (3,5-ジクロ ロフェニル) アミノ] ジフェニル、4- [N,N-ジ (2,6 ージクロロフェニル) アミノ] - 4′ - [N,N-ジ (3,5

-ジ (3,5-ジプロモフェニル) アミノ] -4' - (N,N -ジフェニルアミノ) ジフェニル、4,4' - ピス [N - (3,5-ジプロモフェニル) - N -フェニルアミノ] ジフェニル、4,4' - ピス [N,N-ジ (3,5-ジプロモフェニル) アミノ] ジフェニル、4,4' - ピス [N - (3,5-ジクロロフェニル) - N -フェニルアミノ] -2,2' -ジクロロジフェニル、4,4' - ピス [N,N-ジ (3,5-ジクロロフェニル) アミノ] -2,2' -ジクロロジフェニル アミノ] -2,2' -ジクロロジフェニルなどが例示される。

また、1=3 の4,4'' -テルフェニルジアミン誘導体 のうち、好ましい化合物としては、例えば、4-[N-(3,5-3) (3,5-3) (3,5-3) (3,5-3) (3,5-3) (3,5-3)4″- (N,N-ジフェニルアミノ) -1,1′:4′,1″-テ ルフェニル、4 - [N,N-ピス (3,5-ジメチルフェニル) アミノ] -4'' - (N, N-ジフェニルアミノ) -1,1':4',1"-テルフェニル、4,4"-ビス[N-(2,4 -ジメチルフェニル) - N - フェニルアミノ] -1,1':4',1"-テルフェニル、4,4"-ビス[N-(2,6-ジ メチルフェニル) -N-フェニルアミノ] -1,1':4'、 1" -テルフェニル、4,4" -ピス [N - (3,5-ジメチ ルフェニル) - N - フェニルアミノ] -1,1′:4′,1″ ーテルフェニル、4,4″ - ピス [N,N-ジ (3,5-ジメチ ルフェニル) アミノ] -1,1':4',1" -テルフェニ ル、4 - [N, N-ジ (2, 4-ジメチルフェニル) アミノ] $-4" - [N, N-\Im (2, 6-\Im J + N)]$ -1,1':4',1" -テルフェニル、4 - [N,N-ジ (2,4 ージメチルフェニル) アミノ] - 4″ - [N,N-ジ (3,5 **ージメチルフェニル) アミノ] −1,1′:4′,1″ーテル** フェニル、4 - [N, N-ジ (2,6-ジメチルフェニル) アミノ] - 4″ - [N,N-ジ (3,5-ジメチルフェニル) ア **ミノ]** −1,1′:4′,1″ −テルフェニル、4,4″ −ビス [N-(3,5-3)] - N-(3,5-3)ルフェニル) アミノ] -1,1':4',1" -テルフェニ ル、4,4'' -ピス [N-(3,5-ジメチルフェニル)-N− (3,5-ジイソプロピルフェニル)アミノ]−1,1′: 4',1"-テルフェニル、4,4"-ビス[N-(3,5-ジ メチルフェニル) -N-フェニルアミノ] -3,3″ -ジメチルー1,1′ー:4′,1″ーテルフェニル、4,4″ービス [N-(3,5-3)] + N-7ノ] -3,3′,3″ -トリメチル-1,1′:4′,1″ -テルフ エニル、4,4″ - ピス [N,N-ジ (3,5-ジメチルフェニ ル) アミノ] -3,3′,3″-トリメチル-1,1′:4′,1″ -テルフェニル、4,4″-ビス [N-(3,5-ジメチルフ エニル) - N - フェニルアミノ] -3,3′ 3″ - トリメ トキシー1,1':4',1"ーテルフェニル、4,4"ーピス [N,N-ジ (3,5-ジメチルフェニル) アミノ] -3,3" -ジメトキシ-1,1':4',1"-テルフェニル、4,4"- $\forall X [N-(3,5-3)] + (3,5-3) + (3,5-3$ P = [-3,3',3'] - [-1,1'] + [-1,1']ルフェニル、4,4″ーピス [N,N-ジ (3,5-ジメチルフ

12 ェニル) アミノ] -3,3' ,3" -トリクロロ-1,1': 4',1"-テルフェニル、4,4"-ビス[N-(2,4-ジ メトキシフェニル) -N-フェニルアミノ] -1,1': 4′,1″ーテルフェニル、4,4″ービス [N-(2,6-ジ メトキシフェニル) -N-フェニルアミノ] -1.1':4′,1″ーテルフェニル、4,4″ーピス [N- (3,5-ジ メトキシフェニル) -N-フェニルアミノ] -1,1': 4',1"ーテルフェニル、4,4"-ビス[N,N-ジ(3,5-ジメトキシフェニル) アミノ] -1,1':4',1" -テル 10 フェニル、4 - [N, N-ジ (2, 4-ジメトキシフェニル)アミノ] -4" - [N,N-ジ (2,6-ジメトキシフェニ ル) アミノ] -1,1':4',1" -テルフェニル、4-[N,N-ジ (2,4-ジメトキシフェニル) アミノ] - 4" - [N,N-ジ (3,5-ジメトキシフェニル) アミノ] -1, 1′:4′,1″ーテルフェニル、4-[N,N-ジ(2,6-ジメトキシフェニル) アミノ] -4" - [N,N-ジ (3,5-ジメトキシフェニル) アミノ] −1,1′:4′,1″ーテル フェニル、4,4″-ビス [N- (3,5-ジエトキシフェニ ル) - N - フェニルアミノ] -1,1':4':1" - テルフ 20 ェニル、4,4" - ピス [N,N-ジ (3,5-ジェトキシフェ **ニル)アミノ]-1,1′:4′,1″-テルフェニル、4,4″** - ビス [N- (3,5-ジプロポキシフェニル) - N-フ ェニルアミノ] -1,1':4',1" -テルフェニル、4,4" -ビス [N,N-ジ (3,5-ジプロポキシフェニル) アミ ノ] -1,1':4',1" -テルフェニル、4,4" - ピス[N -(3,5-ジイソプロポキシフェニル) - N - フェニルアミノ] -1,1':4',1" -テルフェニル、4,4" -ビス [N,N-ジ (3,5-ジイソプロポキシフェニル) アミノ] -1,1':4',1"-テルフェニル、4,4"-ピス[N-(3,5-ジプトキシフェニル) -N-フェニルアミノ] -1,1':4',1" -テルフェニル、4,4" -ピス [N,N-ジ (3,5-ジプトキシフェニル) アミノ] -1,1':4', 1" -テルフェニル、4,4" -ビス [N- (3,5-ジイソ ブトキシフェニル) - N - フェニルアミノ] -1,1': 4′,1″ーテルフェニル、4,4″ービス [N,Nージ (3,5-ジイソプトキシフェニル) アミノ] -1,1':4',1"-テルフェニル、4,4'' -ビス [N-(3,5-ジ-tert-ブトキシフェニル) -N-フェニルアミノ] -1,1':4',1" -テルフェニル、4,4" -ピス [N,N-ジ (3,5-ジー tert- \vec{J} \(\tau \) = 1,1' : 4',1'' = 1テルフェニル、4,4" - ビス [N-(2,4-ジクロロフェ フェニル、4,4″ - ピス [N - (2,6-ジクロロフェニ ル) -N-フェニルアミノ] -1,1':4',1"-テルフェニル、4,4'' - ピス [N-(3,5-ジクロロフェニル)]-N-7 -N-7 ル、4,4″ - ピス [N,N-ジ (3,5-ジクロロフェニル) アミノ] -1,1′:4′,1″ーテルフェニル、4- [N,N-ジ (2,4-ジクロロフェニル) アミノ] 4″- [N,N-ジ (2,6-ジクロロフェニル) アミノ] -1,1':4',1"-

テルフェニル、4-[N,N-ジ(2,4-ジクロロフェニル) アミノ] -4~-[N,N-ジ(3,5-ジクロロフェニル) アミノ] -1,1′:4′,1″-テルフェニル、<math>4-[N,N-ジ(2,6-ジクロロフェニル) アミノ] -4~-[N,N-ジ(3,5-ジクロロフェニル) アミノ] -1,1′:4′,1″-テルフェニルなどが例示される。

上記ジアミン誘導体は一種または二種以上混合して用いられる。なお、上記ジアミン誘導体は、分子の対称性がよく、従来の4 - (N,N-ジエチルアミノ) ベンズアルデヒド N,N-ジフェニルヒドラゾンや、N-メチルー3-カルバゾリルアルデヒド N,N-ジフェニルヒドラゾンなどのように光照射により異性化反応などが生じず、光安定性に優れているだけでなく、ドリフト移動度に関する電界強度体が大きく、しかもドリフト移動度に関する電界強度体を性が小さい。より具体的には、4,4′-ピス [N-(3,5-ジメチルフェニル)-N-フェニルアミノ] ジフェニル (化合物A)を例にとって説明すると、電界として2.0×10 5 V/cm 2 (高電界)を作用させた場合、従来の電荷輸送材料、例えば、ポリピニルカルバゾール (化合物B)、N-エチル-3-カルバゾリルアルデヒド N,N-ジフェニルヒドラゾン

$$H_{2}N + (R^{2})_{1} + (R^{2})_{2} + (R^{2})_{3} + (R^{2})_{4} + (R^{2})_{5} + (R^{2$$

(式中、 \mathbb{R}^1 、 \mathbb{R}^2 、 \mathbb{R}^3 、 \mathbb{R}^4 、 \mathbb{Y} 、 $\mathbb{1}$ 、 \mathbb{m} 、 \mathbb{n} 、 \mathbb{O} および \mathbb{P} は前記に同じ。 \mathbb{X} はハロゲン原子を示す。)

上記一般式(2)で表される化合物と一般式(3)~(6)で表される化合物との反応は、通常有機溶媒中で行われ、溶媒としてはこの反応に悪影響を及ぼさない溶媒であればいずれの溶媒も使用でき、例えば、ニトロベンゼン、ジクロロベンゼン、キノリン、N,Nージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドン、ジメチルスルホキシドなどの有機溶媒が例示される。該反応は、通常、銅粉、酸化銅、ハロゲン化銅などの触媒、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリムウ、炭酸カリウムなどの塩基、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムなどの塩基

(化合物 C) や、1-7ェニル-3-(4-3)ェチルアミノスチリル) -5-(4-3)ェチルアミノフェニル) ピラゾリン (化合物 D) に比べて、下表に示すようにドリフト移動度が大きく電界強度依存性が小さい。

14

	ドリフト移動度 (×10 ⁻⁶ ca/V。sec.)	
	低電界	強電界
化合物A	1.8	2,5
化合物B	0, 18	0,65
化合物C	0, 45	1.0
化合物D	0, 11	0.31

感光層が、上記のような特性を有するジアミン誘導体を含有するので、高感度で残留電位の小さな感光体が得られる。

なお、上記一般式(1)で表される化合物は、種々の方法、例えば、下記一般式(2)で表される化合物と一20 般式(3)~(6)で表される化合物とを同時または順次反応させることにより製造することができる。

性物質の存在下、150~250℃の温度で行なわれる。

また、一般式(1)で表される化合物において、置換基 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 の置換位置などが制御されているとともに、対称構造を有する一般式(1)で表される化合物は、例えば、下記一般式(7)で表される化合物と一般式(3)(5)で表される化合物との反応により一般式(8)で表される化合物を得た後、次いで、一般式(8)で表される化合物を得た後、さらに一般式(9)で表される化合物を得た後、さらに一般式(4)(6)で表される化合物と反応させることにより製造することができる。

(式中、 \mathbb{R}^5 および \mathbb{R}^6 は低級アルキル基を示し、 \mathbb{R}^1 、 \mathbb{R}^2 、 ${f R}^3$ 、 ${f R}^4$ 、 ${f Y}$ 、 ${f 1}$ 、 ${f m}$ 、 ${f n}$ 、 ${f o}$ および ${f p}$ は前記に同じ。 ${f X}$ はハロゲン原子を示す。)

上記一般式(7)で表される化合物と一般式(3) (5) で表される化合物との反応は、前記一般式 (2) で表される化合物と一般式(3)~(6)で表される化 合物との反応と同様にして行なうことができる。一般式 (8)で表される化合物の脱アシル化反応は、塩基性触 媒の存在下、常法により行なうことができる。また、上 記一般式(9)で表される化合物と一般式(4) (6) で表される化合物との反応は、前記一般式 (2) で表さ れる化合物と一般式(3)~(6)で表される化合物と の反応と同様に行なうことができる。

反応終了後、反応混合物を濃縮し、再結晶、溶媒抽 出、カラムクロマトグラフィー等の慣用の手段で容易に 分離精製することができる。

前記一般式(1)で表される化合物を含有する感光層 としては、電荷発生材料と上記一般式 (1) の化合物と 結着樹脂とを含有する単層型感光層や、少なくとも電荷 発生材料を含有する電荷発生層と、上記一般式 (1) で 表される化合物と結着樹脂とを含有する電荷輸送材料と が積層された積層型感光層のいずれであってもよい。ま た、上記積層型感光層は、電荷発生層上に電荷輸送層が 形成されていたり、これとは逆に電荷輸送層上に電荷発 生層が形成されていてもよい。

上記電荷発生材料としては、例えば、セレン、セレン ーテルル、アモルファスシリコン、ピリリウム塩、アゾ 系化合物、ジスアゾ系化合物、フタロシアニン系化合 物、アンサンスロン系化合物、ペリレン系化合物、イン ジゴ系化合物、トリフェニルメタン系化合物、スレン系 化合物、トルイジン系化合物、ピラゾリン系化合物、他 のペリレン系化合物、キナクリドン系化合物等が例示さ れる。上記電荷発生材料は、一種または二種以上使用さ

れる。

なお、上記電荷発生材料は、適宜選択することができ 20 るが、分光感度を高めるため、フタロシアニン系化合 物、例えば、 α 型、 β 型、 γ 型など、種々の結晶型を有 するアルミニウムフタロシアニン、銅フタロシアニン、 中でもメタルフリーフタロシアニンおよび/またはチタ ニルフタロシアニンを含有するものが好ましい。上記フ タロシアニン系化合物は、適宜の粒径を有していてもよ いが、平均粒径0.1μm以下のものが好ましい。メタル フリーフタロシアニンの平均粒径が0.1μmを越えると 感光体の感度が低下する。

また、上記結着樹脂としては、種々のもの、例えば、 30 スチレン系重合体、アクリル系重合体、スチレンーアク リル系共重合体、ポリエチレン、エチレン-酢酸ピニル 共重合体、塩素化ポリエチレン、ポリプロピレン、アイ オノマー等のオレフィン系重合体、ポリ塩化ビニル、塩 化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリエステル、アルキ ッド樹脂、ポリアミド、ポリウレタン、エポキシ樹脂、 ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリスルホン、 ジアリルフタレート樹脂、シリコーン樹脂、ケトン樹 脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリエーテル樹脂、フ エノール樹脂や、エポキシアクリレート等の光硬化型樹 脂等、各種の重合体が例示される。上記結着樹脂は一種 または二種以上用いられる。

なお、前記のように一般式 (1) で表される化合物 は、電荷の輸送性に優れ、高感度で残留電位が小さな感 光体が得られるが、必要に応じて、帯電特性、感光特性 などを阻害しない範囲で、他の電荷輸送材料と併用して もよい。上記他の電荷輸送材料としては、例えば、テト ラシアノエチレン、2,4,7-トリニトロ-9-フルオレ ノン等のフルオレノン系化合物、2,4,8-トリニトロチ オキサントン、ジニトロアントラセン等のニトロ化化合

50 物、無水コハク酸、無水マレイン酸、ジブロモ無水マレ

イン酸、2,5-ジ(4-ジメチルアミノフェニル)-1,3,4-オキシジアゾール等のオキサジアゾール系化合物、9-(4-ジエチルアミノスチリル)アントラセン等のスチリル系化合物、ポリビニルカルバゾール等のカルバゾール系化合物、1-フェル-3-(p-ジメチルアミノフェニル)ピラゾリン等のピラゾリン系化合物、インドール系化合物、オキサゾール系化合物、イソオキサゾール系化合物、チアジアル系化合物、チアゾール系化合物、ピラゾール系化合物、トリアゾール系化合物等の含窒素環式化合物、縮合りアゾール系化合物等の含窒素環式化合物、縮合りアゾール系化合物等の含窒素環式化合物、縮合りアゾール系化合物等が例示される。なお、前記電荷輸送材料としての光導電性ポリマー、例えば、ポリーNービニルカルバゾール等は結着樹脂として使用してもよい。

また、感光層は、ターフェニル、ハロナフトキノン類、アセナフチレン等、従来公知の増感剤、9-(N,N-ジフェニルヒドラジノ)フルオレン、9-カルパゾリルイミノフルオレンなどのフルオレン系化合物、可塑剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤などの劣化防止剤等、種々の添加剤を含有していてもよい。

前記単層型感光層における電荷発生材料と一般式 (1)で表される化合物と結着樹脂との使用割合は、特に限定されず、所望する電子写真用感光体の特性等に応じて適宜選択することができるが、結着樹脂100重量部に対して電荷発生材料2~20重量部、特に3~15重量部、一般式(1)で表される化合物40~200重量部、特に50~100重量部からなるものが好ましい。電荷発生材料および一般式(1)で表される化合物が上記量よりも少ないと、感光体の感度が十分でないばかりか、残留電位が大きくなる。また上記範囲を越えると感光体の耐摩耗性等が十分でなくなる。

なお、単層型感光層において、前記フタロシアニン系化合物は適宜量含有されるが、上記結着樹脂100重量部に対して0~2重量部含有されたものが好ましい。フタロシアニン系化合物の量が2重量部を越えると、上記フタロシアニン系化合物が長波長領域に分光感度を有するため、赤色再現性が十分でなくなる。

単層型感光層は、適宜の厚みを有していてもよいが、 $10\sim50\,\mu\,\mathrm{m}$ 、特に $15\sim25\,\mu\,\mathrm{m}$ の厚みを有するものが好ましい。

また、積層型感光層における電荷発生層は、前記電荷発生材料からなる蒸着膜、スパッタリング膜などで形成されていてもよく、電荷発生層が結着樹脂とともに形成されている場合、電荷発生層における電荷発生材料と結着樹脂との割合は適宜設定することができるが、結着樹脂100重量部に対して電荷発生材料5~5000重量部、特に10~2500重量部からなるものが好ましい。電荷発生材料が5重量部未満であると電荷発生能が小さく、5000重量部を越えると密着性が低下する等の問題がある。上記電荷発生層は、適宜の厚みを有していてもよいが、0.01~30μm、特に0.1~20μm程度の厚みを有するものが

好ましい。

また、電荷翰送層における一般式 (1)で表される化合物と結着樹脂との割合は適宜設定することができるが、結着樹脂100重量部に対して、一般式 (1)で表される化合物10~500重量部、特に25~200重量部からなるものが好ましい。一般式 (1)で表される化合物が、10重量部未満であると電荷輸送能が十分でなく、500重量部を越えると電荷輸送層の機械的強度等が低下する。上記電荷輸送層は、適宜の厚みを有していてもよいが、2~100μm、特に5~30μm程度の厚みを有するものが好ましい。

上記単層型感光層は、電荷発生材料と一般式(1)で表される化合物と結着樹脂などを含有する感光層用分散液を調製し、該分散液を前記導電性基材に塗布し、乾燥させることにより形成することができる。また、積層型感光層は、電荷発生材料と結着樹脂などを含有する電荷発生層用分散液と、前記一般式(1)で表される化合物と結着樹脂などを含有する電荷輸送層用塗布液をそれぞれ調製し、導電性基材に順次塗布し、乾燥させることに20 より形成することができる。

また、上記分散液などの調製に際しては、使用される 結着樹脂等の種類に応じて種々の有機溶剤を使用するこ とができる。上記溶剤としては、n-ヘキサン、オクタ ン、シクロヘキサン等の脂肪族系炭化水素、ベンゼン、 トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素、ジクロロメタ ン、ジクロロエタン、四塩化炭素、クロロベンゼン等の ハロゲン化炭化水素、ジメチルエーテル、ジエチルエー テル、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチ ルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、ジ 30 エチレングリコールジメチルエーテル等のエーテル類、 アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン等の ケトン類、酢酸エチル、酢酸メチル等のエステル類、ジ メチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド等、種々の 溶剤が例示され、一種または二種以上混合して用いられ る。なお、上記分散液などを調製する際、分散性、塗工 性等をよくするため、界面活性剤、レベリング剤等を併 用してもよい。

また、上記分散液などは、従来慣用の方法、例えば、ミキサ、ボールミル、ペイントシェーカー、サンドミル、アトライター、超音波分散器等を用いて調製することができ、得られた分散液などを前記導電性基材に塗布し、加熱して溶剤を除去することにより、本発明の電子写真用感光体を得ることができる。

なお、前記導電性基材と感光層との密着性を高めるため、導電性基材と感光層との間に下引き層を形成してもよい。該下引き層は、天然または合成高分子を含有する溶液を塗布し、乾燥後の膜厚が0.01~1μm程度になるように形成される。また、前記感光層を保護するため、感光層上に表面保護層を形成してもよい。前記表面保護 50 層は、前記種々の結着樹脂や、該結着樹脂と劣化防止材

等の添加剤との混合液を通常、乾燥後の膜厚0.1~10μ m、好ましくは0.2~5μm程度に塗布することにより 形成される。

本発明の電子写真用感光体は、感光層が、前記一般式 (1) で表される化合物を含有しているため、光安定性 に優れると共に、感度および表面電位が高く、しかも残 留電位が小さい。従って、本発明の電子写真用感光体 は、複写機、レーザビームプリンターなどで使用される 感光体として有用である。

<実施例>

以下に、実施例に基づき、この発明をより詳細に説明 する。

実施例1

ポリビニルブチラール (積水化学社製、商品名エスレ ックC) 140重量部に対して、β型メタルフリーフタロ シアニン70重量部およびペンゼン700重量部をボールミ ルに仕込み、24時間混合分散して電荷発生層用分散液を 調製した。上記電荷発生層用分散液をアルマイト処理さ れたアルミニウム板上に塗布し、膜厚約0.5μmの電荷 発生層を形成した。

また、ポリエステル(東洋紡社製、商品名バイロン20 0) 100重量部に対して、4,4′-ビス[N-(3,5-ジメ チルフェニル) -N-フェニルアミノ] ピフェニル<math>70重 量部およびテトラヒドロフラン800重量部を用い、攪拌 混合して、電荷輸送層用塗布液を調製し、上記電荷発生 層上に塗布し、膜厚約18μmの電荷輸送層を形成するこ とにより、積層型感光層を有する電子写真用感光体を作 製した。

実施例2

実施例1の4,4′-ビス[N-(3,5-ジメチルフェニ ル) - N - フェニルアミノ] ビフェニルに代えて、4. 4' - ビス [N- (3,5-ジメトキシフェニル) - N-フ ェニルアミノ] ピフェニルを用い、上記実施例1と同様 にして電子写真用感光体を作製した。

実施例3

実施例1の4,4′-ピス[N-(3,5-ジメチルフェニ ν) -N-フェニルアミノ] ピフェニルに代えて、4,4' -ビス [N-(3,5-ジクロロフェニル) -N-フェニルアミノ] ビフェニルを用い、上記実施例1と同様に して電子写真用感光体を作製した。

実施例4

実施例1の4,4′ービス[N-(3,5-ジメチルフェニ ν) -N-フェニルアミノ] ピフェニルに代えて、4,4′-ピス [N,N-ジ (3,5-ジメチルフェニル) アミ ノ] ビフェニルを用い、上記実施例1と同様にして電子 写真用感光体を作製した。

実施例5

実施例104,4'-ビス[N-(3,5-ジメチルフェニ ル) - N - フェニルアミノ] ピフェニルに代えて、4,

-メチルフェニル) アミノ] ピフェニルを用い、上記実 施例1と同様にして電子写真用感光体を作製した。 実施例6

20

実施例1の4,4′-ビス[N-(3,5-ジメチルフェニ ル) - N - フェニルアミノ] ピフェニルに代えて、4-[N-(2,4-ジメチルフェニル)-N-フェニルアミ J] -4' - [N - (3,5-ジメチルフェニル) - N -フェニルアミノ]ビフェニルを用い、上記実施例1と同 様にして電子写真用感光体を作製した。

10 実施例7

実施例1の4,4′-ビス[N-(3,5-ジメチルフェニ ル) - N - フェニルアミノ] ピフェニルに代えて、1,4 ルアミノ] ベンゼンを用い、上記実施例1と同様にして 電子写真用感光体を作製した。

実施例8

実施例1の4,4′-ビス[N-(3,5-ジメチルフェニ ν) -N-フェニルアミノ] ピフェニルに代えて、4,**4″-ビス[N-(3,5-ジメチルフェニル)-N-フェ** 20 二ルアミノ]-1,1':4',1"-テルフェニルを用い、 上記実施例1と同様にして電子写真用感光体を作製し た。

実施例9

実施例1の分型メタルフリーフタロシアニンに代え て、ジブロモアンサンスロンを用い、上記実施例1と同 様にして電子写真用感光体を作製した。

実施例10

実施例1の8型メタルフリーフタロシアニンに代え て、N, N-ジ (4-メチルフェニル) ペリレン-3,4,9,130 0-テトラカルボキシジイミドを用い、上記実施例1と 同様にして電子写真用感光体を作製した。

比較例1

実施例1の4,4′-ヒス[N-(3,5-ジメチルフェニ ル) - N - フェニルアミノ] ピフェニルに代えて、4-(N,N-ジエチルアミノ) ベンズアルデヒド N,N-ジフ ェニルヒドラゾンを用いて、上記実施例1と同様にして 積層型感光層を有する電子写真用感光体を作製した。 比較例2

実施例1の分型メタルフリーフタロシアニンおよび4, $40 \ 4' - \forall x \ [N - (3,5 - \forall x) + (3,5 - x)] - N - 7x$ ニルアミノ] ピフェニルに代えて、N,N-ジ (4-メチ ルフェニル)ペリレン-3,4,9,10-テトラカルポキシジ イミドおよびN-エチル-3-カルパゾリルアルデヒド N,N-ジフェニルヒドラゾンを用いて、上記実施例1 と同様にして電子写真用感光体を作製した。

実施例1の分型メタルフリーフタロシアニンおよび4, 4′-ビス [N-(3,5-ジメチルフェニル)-N-フェ ニルアミノ] ピフェニルに代えて、N,N′ージ (4-メ

そして、上記実施例および比較例で得られた電子写真用感光体の帯電特性、感光特性を調べるため、静電複写紙試験装置(川口電機社製、SP-428型)を用いて、-6.0KVの条件でコロナ放電を行なうことにより、前記各実施例および比較例の電子写真用感光体を帯電させた。

なお、各感光体の表面電位Vs.p. (V) を測定すると共に、照度10ルックスのタングステンランプを用いて、感光体表面を露光し、上記表面電位Vs.p.が1/2となるまでの時間を求め、半減露光量E1/2 $(\mu J/cm^2)$ を算出した。また、露光後、0.15秒経過後の表面電位を残留電位Vr.p. (V) とした。

上記実施例および比較例で得られた各電子写真用感光 体の帯電特性、感光特性の結果を表1に示す。

1

	Vs.p.(V)	Vr.p.(V)	E1/2(μ J/cm²)
実施例 1	655	52	16, 5
実施例 2	648	51	16,8
実施例 3	653	58	17.9
実施例 4	653	59	17,7
実施例 5	660	60	17, 2
実施例 6	648	52	16,8
実施例 7	644	59	18.8
実施例 8	640	60	17.7
実施例 9	660	57	18.0
実施例10	648	60	19.0
比較例 1	650	105	27.0
比較例 2	649	99	29.9
比較例 3	652	97	29, 2

	Vs.p.(V)	Vr.p.(V)	E1/2(μ]/α)
比較例 4	642	109	36, 9

表1から明らかなように、各比較例の感光体は、いずれも感度が十分でなく、残留電位が高いものであった。

これに対して、各実施例の電子写真用感光体は、いずれも半減露光量が小さく、感度がよいと共に、残留電位が小さいことが判明した。

10 また、光照射による感光体の特性の変化を調べるため、上記実施例1および10、比較例1および2の電子写真用感光体を、照度1000ルックスの光源で5分間光照射した後、上記各感光体の特性を上記と同様にして調べ、当初の特性との差を求めたところ、表2に示す結果を得た。

	2

耒

	△Vs.p.	ΔVr.p.	ΔE1∕2
実施例 1	-27	-6	-1.9
実施例10	-18	-4	-1.3
比較例 1	+168	+100	+20
比較例 2	+187	+113	+23

上記表 2 より明らかなように、比較例 1 および 2 の電子写真用感光体は、光照射により、表面電位、残留電位が著しく大きくなるだけでなく、感度が大きく低下し、繰返し特性が十分でないことが判明した。

これに対して、実施例1および10の感光体は、光照射 30 しても、帯電特性、感度特性の変化が少なく、繰返し使 用したときでも、安定した特性を示すことが判明した。 <発明の効果>

以上のように、本発明の電子写真用感光体によれば、 感光層が、特定のジアミン誘導体を含有しているので、 光安定性に優れると共に、感度および表面電位が高く、 しかも残留電位が小さいという特有の効果を奏する。

40

20

フロントページの続き

(56)参考文献 特開 昭58-203446 (JP, A)

· 特開 昭56-119132 (JP, A)

特開 昭63-40166 (JP, A)

特開 昭63-271355 (JP, A)

特開 昭63-113467 (JP, A)

特開 昭62-250458 (JP, A)